

News Release / Presseinformation

Infineon präsentiert die neue, wegweisende Produktfamilie CoolSiC™ 1200V SiC JFET mit Direct Drive-Technologie: Effizienzlevels für Solar-Inverter erreichen neue Dimensionen

Nürnberg, 8. Mai 2012 – Infineon Technologies präsentiert auf der PCIM Europe 2012 erstmals die neue Produktfamilie CoolSiC™ 1200V SiC JFET. Damit unterstreicht Infineon seine Stellung als Marktführer für SiC-Produkte. In die neue, wegweisende Produktlinie fließt die mehr als zehnjährige SiC-Expertise von Infineon in der Technologie-Entwicklung und der qualitativ hochwertigen Volumen-Fertigung.

„Infineon hat bereits mehrfach sehr erfolgreich innovative Technologien für äußerst effizientes Power-Management auf den Markt gebracht“, sagt Jan-Willem Reynaerts, Leiter des Produktsegments High Voltage Power Conversion bei Infineon Technologies. „CoolSiC™ ist erneut eine wegweisende innovative Technologie, mit der bislang unerreichte Wirkungsgrade erzielt werden können – insbesondere in Solar-Invertern. Die neue SiC JFET-Technologie von Infineon ermöglicht unseren Kunden neue, zukunftsweisende Lösungen für den Klimaschutz.“

Die neuen CoolSiC™ 1200V SiC JFETs weisen im Vergleich zu IGBTs signifikant geringere Schaltverluste auf. Damit sind höhere Schaltfrequenzen möglich, ohne die Gesamteffizienz eines Systems zu beeinträchtigen. Es können daher deutlich kleinere passive Komponenten eingesetzt werden: das erlaubt schmalere und leichtere Produktdesigns und senkt die Systemkosten. Alternativ kann im gleichen Gehäuse eine Lösung mit einer höheren Ausgangsleistung umgesetzt werden.

Damit die selbstleitende (normally-on) JFET-Technologie sicher und einfach zu nutzen ist, hat Infineon das Konzept der Direct Drive-Technologie entwickelt. Diese kombiniert den JFET mit einem externen Niederspannungs-MOSFETs und einem speziellen Treiber-IC. Damit kann das System sicher hochgefahren und schnell und kontrolliert geschaltet werden.

In den CoolSiC™ JFET ist eine monolithische Body Diode integriert. Das Schaltverhalten entspricht dem einer externen SiC-Schottky-Diode. Diese

Kombination macht den CoolSiC™ JFET höchst effizient, zuverlässig, sicher und einfach einzusetzen.

Verfügbarkeit & Preise

Muster der CoolSiC™ JFET-Produkte und der Treiber-ICs sind im Laufe des 2. Quartal 2012 verfügbar. Erste Auslieferungen an OEMs erfolgen voraussichtlich im ersten Halbjahr 2013. Der IJW120R100T1 (100mOhm) ist für US\$ 24.9 (€ 18.44) pro Stück ab 1.000 Stück erhältlich.

Weitere Informationen über die neuen CoolSiC™ 1200V SiC JFET Produktfamilie unter www.infineon.com/coolpic

Infineon Technologies präsentiert die neuen CoolSiC™ 1200V SiC JFET-Produkte auf der PCIM Europe 2012 (8.-10. Mai) in Nürnberg in Halle 12, Stand 404.

Über Infineon

Die [Infineon](http://www.infineon.com) Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: [Energieeffizienz](#), [Mobilität](#) sowie [Sicherheit](#). Mit weltweit rund 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2011 (Ende September) einen Umsatz von 4 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen unter www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse